

# МОЩНЫЕ ПОЛЕВЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ (Power MOSFET)

**HARRIS** является мировым лидером в производстве **Power MOSFET**.

Выпускаются как n-канальные, так и p-канальные транзисторы, но первые используются чаще и имеют больший диапазон токов и напряжений. Кроме этого выпускаются полевые транзисторы с управлением сигналом логического уровня, с ограничением тока, с защелкой по напряжению.

Области применения: регуляторы, конвертеры, драйверы двигателей, реле и мощных биполярных транзисторов. Полевые транзисторы имеют очень высокое входное сопротивление и обычно могут управляться непосредственно от микросхемы без дополнительных усилительных каскадов.

## Power MOSFET, серия IRF

Максим. значения		TO-204		TO-220AB		TO-247		DIP-4	
$V_{си, В}$	$I_{си, А}$	$R_{си(отр.), Ом}$							
<b>n-канал</b>									
100	0,4	3,2							IRFD122
	0,8	0,8							IRFD112
	1,3	0,3							IRFD120
	5,6	0,54			IRF510				
	9,2	0,27	IRF120		IRF520				
	14,0	0,16			IRF530				
	28,0	0,077	IRF140		IRF540				
200	40,0	0,055	IRF150					IRFP150	
	0,45	2,4							IRFD212
	0,80	0,8							IRFD220
	3,3	1,5			IRF610				
	5,0	0,8	IRF220		IRF620				
	9,0	0,4	IRF230		IRF630				
	18,0	0,18	IRF240		IRF640				
400	33,0	0,085	IRF250					IRFP250	
	0,4	3,6							IRFD310
	2,0	3,6			IRF710				
	3,3	1,8	IRF320						
	5,5	1,0	IRF330		IRF730				
	10,0	0,55	IRF340		IRF740				
	16,0	0,3	IRF350					IRFP350	
500	23,0	0,2	IRF360					IRFP360	
	2,5	3,0	IRF420		IRF820				
	4,5	1,5	IRF430		IRF830				
	8,0	0,85	IRF440						
	14,0	0,4	IRF450					IRFP450	
1000	20,0	0,27	IRF460					IRFP460	
	4,3	3,5						IRFPG40	
<b>p-канал</b>									
100	1,0	0,6							IRFD9120
	3,0	1,2			IRF9510				
	6,0	0,6			IRF9520				
	12,0	0,3	IRF9130		IRF9530				
	19,0	0,2	IRF9140		IRF9540			IRFP9140	
200	3,5	1,5			IRF9620				
	6,5	0,8	IRF9230		IRF9630				
	11,0	0,5	IRF9240		IRF9640				

## Mega FET серия

Максим. значения		TO-220AB	
$V_{си, В}$	$I_{си, А}$	$R_{си(отр.), Ом}$	
<b>n-канал</b>			
50	14	0,1	RFP14N05
	25	0,047	RFP25N05
	50	0,22	RFP50N05
100	22	0,080	RFP22N10
	40	0,040	RFP40N10
<b>p-канал</b>			
50	8	0,300	RFP8P05
	15	0,150	RFP15P05
	30	0,065	RFP30P05
<b>n-канал, управление логическим уровнем</b>			
50	4	0,800	RFP4N05L
	14	0,100	RFP14N05L
	25	0,047	RFP25N05L
	50	0,022	RFP50N05L
100	2	1,050	RFP2N10L
	7	0,300	RFP7N10LE
	12	0,200	RFP12N10L
200	2	3,500	RFP2N20L
	8	0,500	RFP8N20L
<b>p-канал, управление логическим уровнем</b>			
30	10	0,225	RFP10P03L



Более подробную информацию можно получить по адресу [www.semi.harris.com](http://www.semi.harris.com) или заказав литературу непосредственно у **HARRIS**. Бланк для заказа литературы приведен в каталоге.

## n-канальные MOSFET, серия BUZ

Максим. значения	Максимальные значения			Максим. значения	Максимальные значения			
	$V_{си, В}$	$I_{си, А}$	$R_{си(отр.), Ом}$		$V_{си, В}$	$I_{си, А}$	$R_{си(отр.), Ом}$	
50	14,0	0,1	BUZ71	200	9,5	0,4	BUZ32	
	30,0	0,04	BUZ11		400	3,0	1,8	BUZ76
	9,0	0,25	BUZ72A			5,5	1,0	BUZ60
100	19,0	0,1	BUZ21	500	4,0	2,0	BUZ42	
	5,8	0,6	BUZ73A	1000	4,3	3,5	RFP4N100	

## Улучшенные Power MOSFET

Максим. значения		TO-220AB	
$V_{си, В}$	$I_{си(огр.), А}$	$R_{си(отр.), Ом}$	
80	1	0,75	RLP1N08LE
	5,5	0,12	RLP5N08LE

### RLP1N08LE, RLP5N08LE

Имеют встроенную схему, ограничивающую max значения  $I_{си}$  на уровне 1 А и 5,5 А соответственно. Встроенный стабилизатор защищает от статического электричества до 2 кВ.

Максим. значения		TO-220AB	
$V_{си, В}$	$I_{си(огр.), А}$	$R_{си(отр.), Ом}$	
55	1	0,75	RLP1N06CLE

### RLP1N06CLE

Имеют схему ограничения  $I_{си}$ , защелку по напряжению (уровень 60÷70 В), встроенный стабилизатор для защиты от статического электричества до 2 кВ.